

Silicon Power Schottky Diode

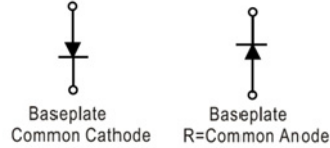
$V_{RRM} = 45 \text{ V} - 100 \text{ V}$

$I_{F(AV)} = 120 \text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 45 V to 100 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

D-67 Package



Maximum ratings, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MBRH12045 (R)	MBRH12060 (R)	MBRH12080 (R)	MBRH120100 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		45	60	80	100	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		32	42	57	70	V
DC blocking voltage	V_{DC}		45	60	80	100	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MBRH12045 (R)	MBRH12060 (R)	MBRH12080 (R)	MBRH120100 (R)	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 125^\circ\text{C}$	120	120	120	120	A
Peak forward surge current	I_{FSM}	$t_p = 8.3 \text{ ms}$, half sine	2000	2000	2000	2000	A
Maximum instantaneous forward voltage	V_F	$I_{FM} = 120 \text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	0.70	0.75	0.84	0.84	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage	I_R	$T_j = 25^\circ\text{C}$	1	1	1	1	mA
		$T_j = 100^\circ\text{C}$	10	10	10	10	
		$T_j = 150^\circ\text{C}$	30	30	30	30	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction-case	$R_{\theta JC}$		0.48	0.48	0.48	0.48	$^\circ\text{C/W}$
-----------------------------------	-----------------	--	------	------	------	------	--------------------

Figure .1-Typical Forward Characteristics

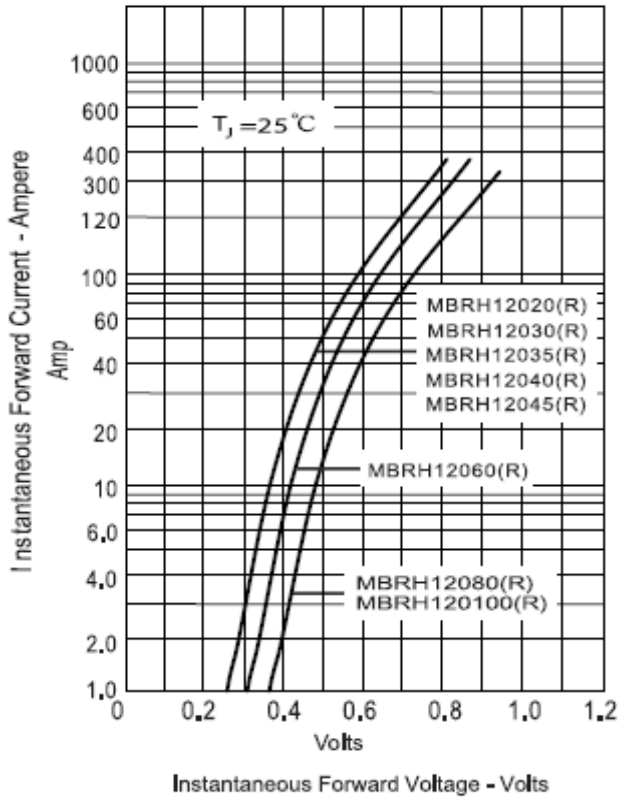


Figure .2-Forward Derating Curve

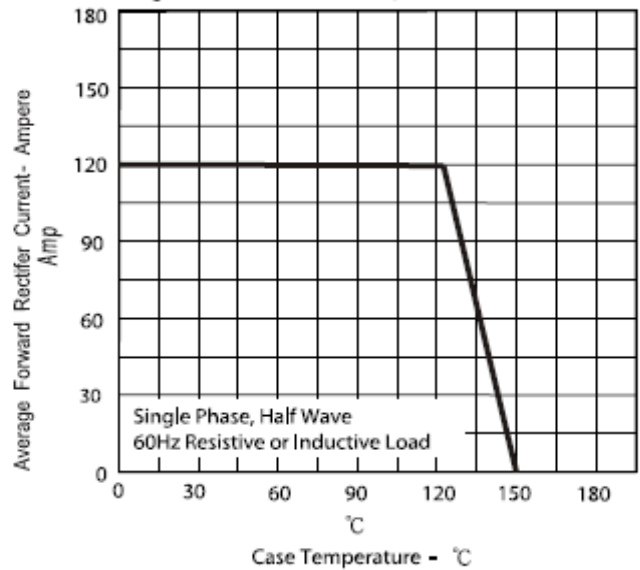


Figure .3-Peak Forward Surge Current

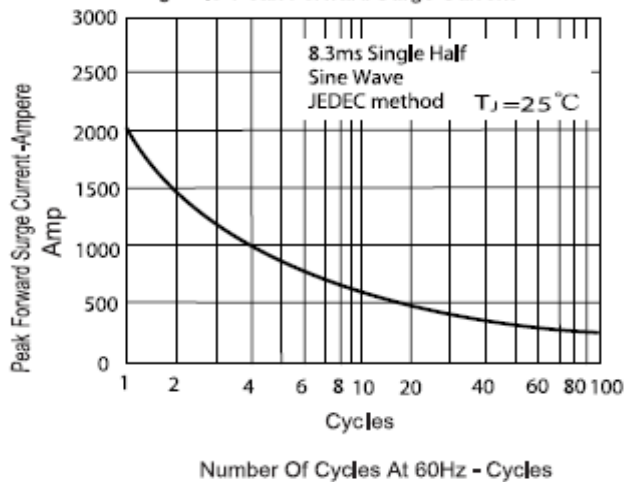
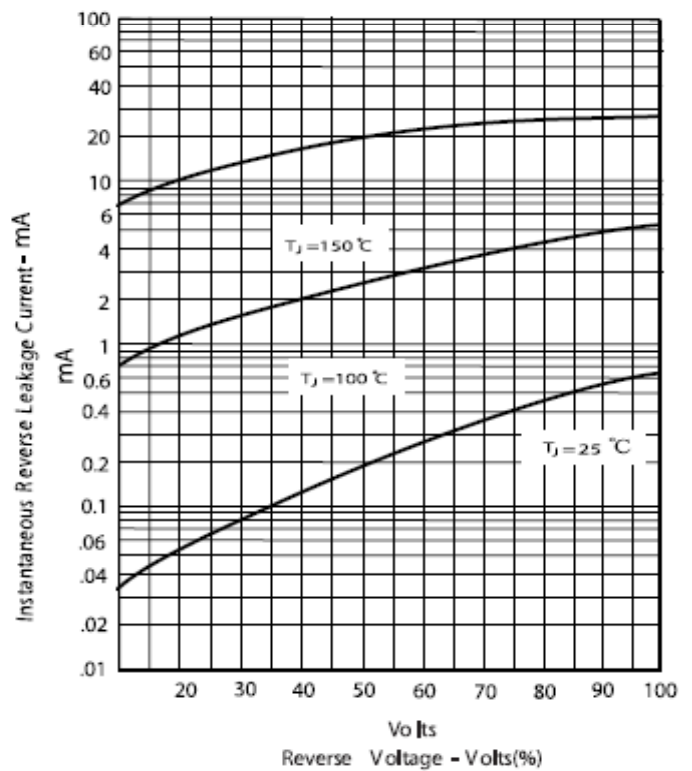
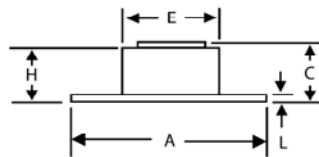
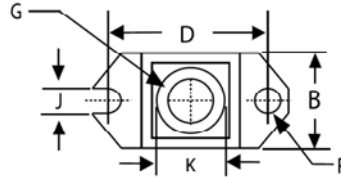


Figure .4- Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



Baseplate
Common Cathode



Baseplate
R=Common Anode

DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.515	1.560	38.48	39.62	
B	.725	.775	18.42	19.69	
C	.595	.625	15.11	15.88	
D	1.182	1.192	30.02	30.28	
E	.736	.744	18.70	18.90	
F	.152	.160	3.86	4.061	Ø
G	1/4- 20 UNC				
H	.540	.580	13.72	14.73	
J	.156	.160	3.96	4.06	
K	.480	.492	12.20	12.50	Ø
L	.120	.130	3.05	3.30	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[MBRH120100](#) [MBRH120100R](#) [MBRH12045](#) [MBRH12045R](#) [MBRH12060](#) [MBRH12060R](#) [MBRH12080](#)
[MBRH12080R](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9